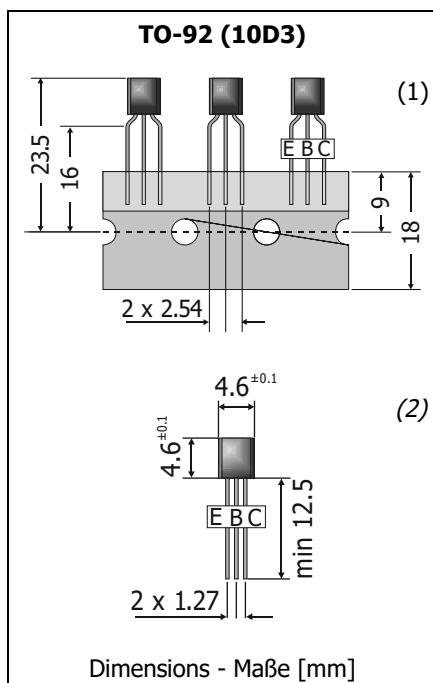


MPSA42 | MPSA44
High Voltage NPN Transistors
Hochspannungs-NPN-Transistoren
 $I_C = 500 \text{ | } 300 \text{ mA}$ $V_{CEO} = 300 \text{ | } 400 \text{ V}$
 $h_{FE1} > 40$ $P_{tot} = 625 \text{ mW}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2017-12-07

**Typical Applications**

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

High collector voltage
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

**Mechanical Data ¹⁾**

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Hohe Kollektorspannung
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	4000
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	5000
Weight ca.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL N/A

Recommended complementary PNP transistors
Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren

MPSA92

-

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

		MPSA42	MPSA44
Collector-Emitter-voltage - Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	300 V 400 V
Collector-Base-voltage - Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	300 V 500 V
Emitter-Base-voltage - Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	6 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ³⁾
Collector current – Kollektorstrom	DC	I_C	500 mA 300 mA
Base current – Basisstrom		I_B	100 mA –
Junction temperature – Sperrsichttemperatur		T_j	-55...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	MPSA42	MPSA44
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom $I_E = 0$ $V_{CB} = 200 \text{ V}$ $V_{CB} = 400 \text{ V}$		I_{CBO} < 100 nA – – < 100 nA	
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom $I_B = 0$ $V_{EB} = 6 \text{ V}$ $V_{EB} = 4 \text{ V}$		I_{EBO} < 100 nA – – < 100 nA	

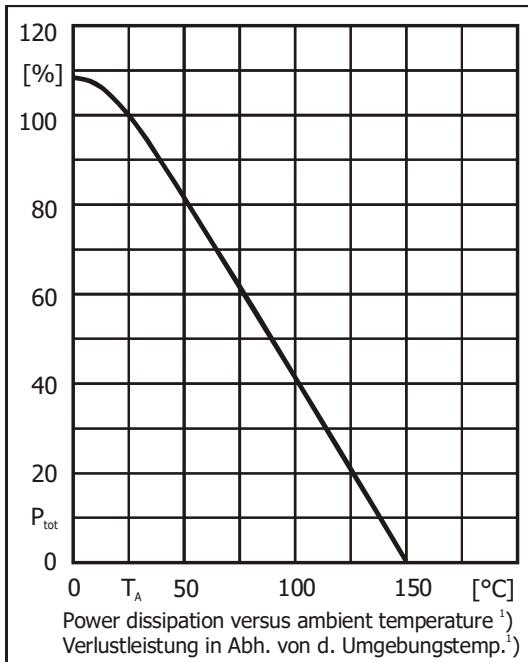
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data bookBitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	MPSA42	Kennwerte MPSA44
Collector saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾			
$I_C = 1 \text{ mA}$ $I_B = 0.1 \text{ mA}$ $I_C = 10 \text{ mA}$ $I_B = 1 \text{ mA}$ $I_C = 20 \text{ mA}$ $I_B = 2 \text{ mA}$ $I_C = 50 \text{ mA}$ $I_B = 5 \text{ mA}$	V_{CEsat}	– – $< 500 \text{ mV}$ –	$< 400 \text{ mV}$ $< 500 \text{ mV}$ – $< 750 \text{ mV}$
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung ¹⁾			
$I_C = 20 \text{ mA}$ $I_B = 2 \text{ mA}$ $I_C = 10 \text{ mA}$ $I_B = 1 \text{ mA}$	V_{BEsat}	$< 900 \text{ mV}$ –	– $< 750 \text{ mV}$
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis			
$V_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 1 \text{ mA}$ $I_C = 10 \text{ mA}$ $I_C = 10 \text{ mA}$ $I_C = 30 \text{ mA}$ $I_C = 50 \text{ mA}$ $I_C = 100 \text{ mA}$	h_{FE}	> 25 > 40 – > 40 – –	> 40 > 50 typ. 200 – > 45 > 40
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz			
$V_{CE} = 20 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$	f_T	$> 50 \text{ MHz}$	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität			
$V_{CB} = 20 \text{ V}$, $I_E = i_e = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$	C_{CBO}	$< 3 \text{ pF}$	$< 7 \text{ pF}$
Thermal resistance junction – ambient Wärmewiderstand Sperrsicht – Umgebung	R_{thA}	$< 200 \text{ K/W}$ ²⁾)	


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from the case

Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:

Click to view products by Diotec manufacturer:

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T\)](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)